## MgO(001)基板上に形成した FePt/FePd 二層薄膜の構造解析

中村将大・落合亮真・野口陽平・大竹充・二本正昭・桐野文良\*・稲葉信幸\*\* (中央大,\*東京藝大,\*\*山形大)

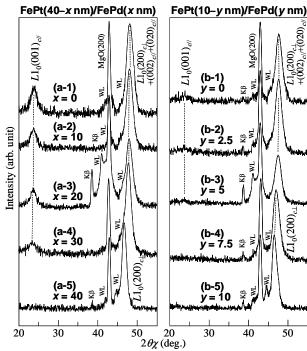
Structure Analysis of FePt/FePd Bilayer Films Formed on MgO(001) Substrate Masahiro Nakamura, Ryoma Ochiai, Youhei Noguchi, Mitsuru Ohtake, Masaaki Futamoto, Fumiyoshi Kirino\*, and Nobuyuki Inaba\*\*

(Chuo Univ., \*Tokyo Univ. Arts, \*\*Yamagata Univ.)

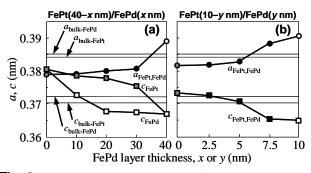
**はじめに**  $L1_0$ 構造を持つバルク FePt および FePd 合金は、それぞれ、 $6.6 \times 10^7$ および  $1.8 \times 10^7$  erg/cm³の  $K_u$ を持つため、これらの薄膜は高密度磁気記録媒体や MRAMなどへの応用に向けて研究されている。デバイス応用では、高規則化に加えて、磁化容易軸である c 軸が面直に向くように方位制御する必要がある。しかしながら、(001)配向下地層や単結晶基板上にこれらの合金膜を形成した場合、c 軸が面直に向いた(001)結晶に加え、面内に存在する(100)結晶が混在する場合が報告されているに存在する(100)結晶が混在する場合が報告されている「3」、我々は、これまで、MgO(001)基板上に  $10 \sim 40$  nm厚の FePt および FePd 膜を形成し、結晶配向について調べてきた 4.5)。FePt 膜では、僅かに  $L1_0$ (100)結晶が混在したが、FePd 膜は、 $L1_0$ (001)結晶のみから構成されていることが分かった。本研究では、FePt/FePd 二層膜を形成することにより、FePt 層の配向制御を試みた。

実験方法 試料作製には超高真空 RF マグネトロンスパッタリング装置を用いた。MgO(001)基板上に 200 °C でFePt(40-x nm)/FePd(x nm)もしくはFePt(10-y nm)/FePd(y nm)二層膜を形成した。製膜後, $L1_0$  相への規則化を促進させるために,600 °C での熱処理を施した。構造評価にはRHEED,XRD,磁気特性評価にはVSMを用いた。

実験結果 作製したすべての膜で、エピタキシャル成 長していることをRHEED観察で、L10相に規則化して いることを面外XRD測定で確認した. c軸が面内に向 いた(100)結晶の有無を調べるために, 面内XRD測定を 行った. Fig. 1(a)にFePt(40-x nm)/FePd(x nm)膜の面内 XRDパターンを示す. いずれの二層膜  $(x = 10 \sim 30 \text{ nm})$ でも $L1_0(001)$ 反射が認められ、 $L1_0(100)$ 結晶が混在して いることが分かる. Fig. 1(b)に総膜厚を10 nmへ減少さ せた場合の結果を示す. FePt: FePd層厚比を1:3とし た試料では $L1_0(001)$ 反射が観察されていない. c軸が面 直に向いたL10(001)結晶からなる膜構造が実現できて いる. Fig. 2に面内および面外XRD測定の結果から算 出した面内格子間隔aと面外間隔cを示す. 総膜厚を40 から10 nmへ, さらにFePd層比を増加させると, 面内 格子は膨張し面外格子が収縮する傾向が認められる. このような格子歪がc面配向の促進に寄与しているこ とが考えられる.



**Fig. 1** In-plane XRD patterns of (a) FePt(40-x nm) /FePd(x nm) and (b) FePt(10-y nm)/FePd(y nm) bilayer films deposited on MgO(001) substrates.



**Fig. 2** Lattice parameters, a and c, of (a) FePt(40–x nm) /FePd(x nm) and (b) FePd(10–y nm)/Pd(y nm) bilayer films.

参考文献 1) K. Sato, B. Bian, and Y. Hirotsu: J. Appl. Phys., 91, 8516 (2002).

- 2) Y. K. Takahashi, K. Hono, T. Shima, and K. Takanashi: J. Magn. Magn. Mater., 267, 248 (2003).
- 3) H. Ho, J. Zhu, A. Kulovits, D. E. Laughlin, and J. Zhu: *J. Appl. Phys.*, **116**, 193510 (2014).
- 4) A. Itabashi, M. Ohtake, S. Ouchi, F. Kirino, and M. Futamoto: J. Magn. Soc. Jpn., 37, 358 (2013).
- 5) M. Ohtake, A. Itabashi, M. Futamoto, F. Kirino, and N. Inaba: IEEE Trans. Magn., 50, 2104204 (2014).